**Баранов Глеб Владимирович. Эффекты пространственного распределения дефектов и примесных атомов в слоистых структурах на основе Si при ионной имплантации: автореферат дис. ... кандидата Физико-математических наук: 05.27.01 / Баранов Глеб Владимирович;[Место защиты: ФГБУН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук], 2018**